

	<h2 style="color: red;">FQD1N80TM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD1N80TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD1N80TM.pdf  2.FQD1N80TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 111229 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N80TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	111229 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD1N80TMCT

















































FQD1N80TM ist neu im Original, Suche FQD1N80TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N80TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD1N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1P50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.2A DPAK</p>	 <p>FQD1N80 FAIRCHILD FQD1N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD1P50TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.2A DPAK</p>
 <p>FQD1P50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.2A DPAK</p>	 <p>FQD1P50 FAI FQD1P50 FAI</p>	 <p>FQD1N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD17P06TM	 FQD17P06TM	 FQD18N20V2	 FQD18N20V2TM	 FQD18N20V2TM
 FQD19N10	 FQD19N10L	 FQD19N10LTM	 FQD19N10LTM	 FQD19N10TF
 FQD19N10TF	 FQD19N10TM	 FQD19N10TM	 FQD1N50B	 FQD1N50TF
 FQD1N50TF	 FQD1N60C	 FQD1N60CTF	 FQD1N60CTF	 FQD1N60CTM
 FQD1N60CTM	 FQD1N60TF	 FQD1N60TF	 FQD1N60TM	 FQD1N60TM
 FQD1N80TM	 FQD1P50TM	 FQD1P50TM	 FQD20N06	 FQD20N06-NL
 FQD20N06L	 FQD20N06LE	 FQD20N06LETM	 FQD20N06LETM	 FQD20N06LTF
 FQD20N06LTF	 FQD20N06LTM	 FQD20N06LTM	 FQD20N06LTU	 FQD20N06TF
 FQD20N06TF	 FQD20N06TM	 FQD20N06TM	 FQD24N08	 FQD24N08TF
 FQD24N08TF	 FQD24N08TM	 FQD24N08TM	 FQD2N100	 FQD2N100TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

